

RFMD 新聞稿

公司聯繫：

RF Micro Devices Inc.
Irma Swain, Communications Manager
7628 Thorndike Road
Greensboro, NC 27409-9421, USA
Tel: +1 (336) 931-6653
iswain@rfmd.com



RFMD® 發表 MEMS 技術， 以在 RF 及其他應用上達到功能整合之突破性效能及空前層次

紐約州紐約-2007年11月21日 -設計及製造高效能無線電系統及解決方案的全球領導廠商 RF Micro Devices, Inc. (NASDAQ: RFMD)於今日分析日中，發表其用於 RF 和其它應用的專利微機電系統，或稱 MEMS 技術。RFMD 是針對低成本、整合性 RF 應用("RF MEMS")研發 MEMS 技術的先驅，自 2004 年以來，並相當積極投入 MEMS 技術的商品化。RFMD 並預期其專利 MEMS 技術，將在 RF 和其它應用上達到功能整合之突破性效能及空前水準。

由 RFMD 所發表的第一款 RF MEMS 元件，為一 RF MEMS 傳輸/接收開關，以及針對 3G 多模手機的 RF MEMS 模式開關。RFMD 的 MEMS 開關技術，將透過具體縮減產品接腳佔位及提升效率之優勢，具體加速 3G 部署，並延長手機通話時間。一旦針對前端解決方案(GaAs、SOI 和矽晶)結合 RFMD 領導業界的製程技術，RFMD 的 RF MEMS 開關技術將為低成本、小尺寸及高效能前端確立新標準。

RFMD 的 MEMS 開關並將用於功率放大器(PA)之輸出電路以創造可調諧的功率放大器，該公司預期此將致能真正的可調式傳輸器解決方案。

RFMD 研發副總裁 Victor Steel 表示：「RFMD 專利 MEMS 技術的商品化，以及我們 200mm MEMS R&D 廠的建立，都印證了 RFMD 持續對於領導創新之承諾。RFMD 是唯一能以具成本效益、晶圓等級封裝、單晶解決方案組合混合訊號 CMOS、電源管理、功率放大器、RF 交換器及 RF MEMS 的公司。透過我們領導業界的 MEMS 能力之商品化，我們將延展提供高整合性 RF 解決方案的能力，以符合、甚至超越客戶對於新興 RF 之要求。」

加州大學聖地牙哥分校教授、及 MEMS 發展早期先驅 Gabriel M. Rebeiz 補充：「既有的 RF MEMS 開關技術是根據小型製造產量及晶圓對晶圓封裝技術，使得元件成本相當高。RFMD 的矽晶高層次整合方法將能解決此問題，進而提升產能、達到更高的效能及更低成本。」

RFMD 的 RF MEMS 開關為高功率、歐姆接觸 MEMS 開關，其屬於 RF CMOS SOI 晶圓的後製程 above-IC，並被壓縮於密封的晶圓等級封裝(WLP)絕緣棋型架構。操作 RF MEMS 開關所有必要的電路，都整合入下層 CMOS，包括大電壓及用以可靠刺激電源 MEMS 開關的所需控制訊號。RF MEMS 開關完全支援 RFMD 嚴格的蜂巢式 RF 電源模組要求，包括低插入損耗和高隔離(典型值 0.2dB/35dB @ 1.9GHz)以及高諧波拒斥(典型值 >90dBc)，並且同樣符合在設計及製造上對於可靠性及成本的嚴苛要求。

除 RF MEMS 開關外，RFMD 亦積極發展其他 MEMS 元件的商品化，如 RF MEMS 濾波器、RF MEMS 共振器 (crystal replacement) 及 MEMS 感測器。該公司預計其 MEMS 技術搭配既有的高效能無線電頻率系統能力，終將使單晶片前端及軟體定義無線電符合任何通訊協定— 無論蜂巢式或非蜂巢式。

RFMD 並將成立一 200mm R&D 晶圓廠，以支援其持續性的 MEMS 研發。此 MEMS 研發廠將與 RFMD 的 GaN 研發組織共同位於北卡羅萊納州 Mooresville 的新工廠。

關於 RFMD: RF Micro Devices, Inc. (NASDAQ: RFMD) 是針對驅動行動通訊應用，設計及製造高效能無線電系統及解決方案的全球領導廠商。RFMD 的蜂巢式前端、蜂巢式接收器、RF 零組件及系統單晶片 (SOC) 解決方案致能了全球的無線應用，提供強化的連結性、並支援今日及新一代行動電話、蜂巢式基地台、無線區域網路 (WLAN)、CATV 網路、航太、國防及全球定位系統 (GPS) 市場。其公認在裝置產品上工藝等級的半導體技術，以及強大的 RF 系統專長，RFMD 是客戶的優先供應商，使全球領導行動裝置製造商，能提供滿足現今及未來市場需求的先進無線功能。

RFMD 總部設於北卡羅萊納州 Greensboro，已獲得 ISO 9001- 及 ISO 14001- 認證並具備全球性的工程、設計、銷售及服務據點。RFMD 於 NASDAQ 全美國市場以 RFMD 之協議代碼上市，如需進一步資訊，請參閱 RFMD 網站 www.rfmd.com

本新聞稿所包含“前瞻性聲明”，乃根據 1995 年「私人安全訴訟改革法案 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995)」中的「免責規定 (safe harbor)」所為。縱使某些前瞻性聲明的表達有所不同，本文中的前瞻性聲明包括，但不限於關於本公司所擬計畫、目標、陳述及主張之聲明，其非歷史事實，典型以使用諸如：“也許”“將”“應該”“可能”“期望”“計畫”“預測”“相信”“預估”“預測”“潛力”“持續”及相似文字以界定。請注意此前瞻性聲明包含此間所效能管理者目前的判斷及期望，但我們的實際結果、事件及績效將可能與此前瞻性聲明之表達及暗示具有實質性的差異。我們並不會更新這些前瞻性聲明、或公開發表這些前瞻性聲明的修正結果，除非為聯邦證券法規 (federal securities laws) 之要求下。RF Micro Devices 的業務受多種風險及不確定性因素的影響，包括季度運營結果的易變性；無線市場的成長與發展速率；與以下方面相關的風險：晶圓製造、分子束外延與測試，裝配及測試、tape，捲線設備。以及吸引及保留熟練員工及培養領導者的能力，生產良率的易變性，採用新技術以降低成本、提高毛利率的能力，將新產品推向市場的能力；快速增加產能以適應產品需求增長的能力；對有限客戶的依賴，以及對第三方的依賴。在由美國證券協議委員會歸檔的 RF Micro Devices 10-K 報表的最新年度報告中，更詳細討論的這些以及其他風險及不確定性因素，可能導致實際結果及發展與此處任何一個前瞻性聲明中明示或暗示的意義存在本質性偏差。

RF MICRO DEVICES® 及 RFMD® 為 RFMD, LLC 商標。所有其他公司名、商標及註冊商標為其個別擁有者所持有。